

Inicio
 Accesibilidad
 Mapa web
 Contacto
 Directorio

ESTUDIANTES
 PROFESORADO
 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
 VISITANTES Y EMPRESAS

NUESTRA UNIVERSIDAD
 INTERNACIONAL

LISTADO DE CURSOS

ESTUDIOS Y ACCESO

INVESTIGACIÓN

Usted se ha identificado como RUBIO PEÑA LUIS (Salir)

Página Principal ► Mis cursos ► GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA ► 40210015_13_14_01 ► Tema 4 ► Evaluación continua:
 Teoría de Electrónica 2 ► Vista previa

Navegación por el cuestionario

1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10

Terminar intento...

[Comenzar una nueva previsualización](#)

Navegación

Página Principal

- Área personal
- Páginas del sitio
- Mi perfil
- Curso actual
- 40210015_13_14_01
- Participantes
- Informes
- General
- ELECTROTECNIA
- Tema 2
- Tema 3
- Tema 4
- Modelos del diodo de unión
- Hojas de características
- Vídeos divulgativos
- Evaluación continua: Teoría de Electrónica
- **Evaluación continua: Teoría de Electrónica 2**
- Información
- Resultados
- Evaluación continua: Problema 1 de

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



Editar pregunta

¿Qué magnitudes relaciona la curva característica de un transistor de efecto de campo?

Seleccione una:

- a. Intensidad de corriente por la puerta y tensión drenador-fuente.
- b. Intensidad de corriente por la puerta y tensión puerta-fuente.
- c. Intensidad de corriente por el drenador y tensión drenador-fuente.
- d. Intensidad de corriente por el drenador y tensión puerta-fuente.

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



Editar pregunta

Para que en un transistor MOSFET de acumulación de canal p se establezca una corriente eléctrica las tensiones deben ser

Seleccione una:

- a. $V_{GS} > 0$ y $V_{DS} > 0$.
- b. $V_{GS} < 0$ y $V_{DS} < 0$.
- c. $V_{GS} > 0$ y $V_{DS} < 0$.
- d. $V_{GS} < 0$ y $V_{DS} > 0$.

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



Editar pregunta

Considere un transistor de silicio BJT npn donde $V_{BE} = 0.7$ V y $V_{CE} = 6$ V. Dicho transistor se encuentra en la región

Seleccione una:

- a. de saturación
- b. activa directa
- c. de corte

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



Editar pregunta

Un transistor MOSFET de acumulación de canal n en la región óhmica

Seleccione una:

- a. aumenta su resistencia según aumenta VGS.
- b. tiene una resistencia constante.
- c. disminuye su resistencia según aumenta VGS.

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



Editar pregunta

La región de saturación de un transistor

Seleccione una:

- a. MOSFET y para un BJT, corresponde a la zona donde se comportan como una fuente de corriente.
- b. MOSFET corresponde a la zona donde éste se comporta como una fuente de corriente y para un BJT a la zona donde se comporta como fuente de tensión.
- c. BJT corresponde a la zona donde éste se comporta como una fuente de

Electrónica

Evaluación continua:
Problema 2 de Electrónica

Calificaciones evaluación continua parte de Electrónica

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Mis cursos

Ajustes



Administración del cuestionario

- Editar ajustes
- Anulaciones de grupo
- Anulaciones de usuario
- Editar cuestionario
- Vista previa**
 - Filtros
 - Registros
 - Copia de seguridad
- Banco de preguntas

Administración del curso

Cambiar rol a...

Ajustes de mi perfil

Agregar un bloque

corriente y para un MOSFET a la zona donde se comporta como fuente de tensión.

- d. MOSFET corresponde a la zona donde éste se comporta como una fuente de corriente y para un BJT a la zona anterior a la activa directa con valores de tensión entre colector y emisor de valor absoluto bajo.

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



¿En qué regiones de funcionamiento operan como fuentes de corriente los transistores bipolares y los de efecto de campo?

Seleccione una:

- a. Región activa directa y óhmica.
- b. Región de saturación y óhmica.
- c. Región de corte y de saturación.
- d. Región activa directa y de saturación.

Pregunta 7

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



En un transistor de silicio BJT npn polarizado en la región activa directa

Seleccione una:

- a. VCE es aproximadamente 3 V.
- b. VCE es aproximadamente -3 V.
- c. VCE es negativa con un valor que depende del circuito.
- d. VCE es positiva con un valor que depende del circuito.

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



¿En qué región de funcionamiento un transistor de efecto de campo se comporta como una fuente de corriente controlada por tensión?

Seleccione una:

- a. En la región de corte.
- b. En ninguna.
- c. En la región de saturación.
- d. En la región óhmica.

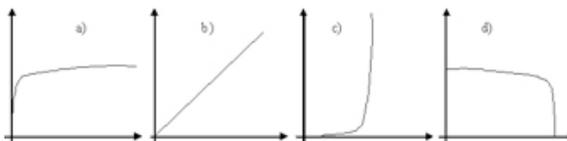
Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



¿Cuál de las siguientes curvas corresponde a la característica de salida de un transistor bipolar de unión?



Seleccione una:

- a. curva c
- b. curva a
- c. curva b
- d. curva d

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00



En un transistor de efecto de campo en la región de corte, ¿qué intensidades de corriente son nulas?

Seleccione una:

- a. Sólo IG
- b. Todas
- c. Sólo IG e ID
- d. Sólo IG e IS

[Siguiendo](#)

© Copyright Universidad de Cádiz

Nuestra Universidad
Estudios y acceso
Investigación
Internacional

Estudiantes
Profesorado
Administración y servicios
Visitantes y compañías

 Universia

[XHTML 1.0](#) | [CSS 2.1](#)
[WAI/AA](#)
Aviso legal
